Облікова картка НДДКР

Державний обліковий номер: 0307U001919

Державний реєстраційний номер: 0106U001656

Відкрита

Дата реєстрації: 13-06-2007

1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розробка технології виготовлення активних елементів на основі GaAs, проведення попередніх випробувань

Початок етапу: 01-2006

Закінчення етапу: 12-2006

Вид звітного документа: Без звіту

2. Виконавець

Назва організації: Інститут технічної механіки НАН України і НКА України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 05539962

Підпорядкованість: Національна академія наук України

Адреса: 49600, Дніпро-5,вул. Лешко-Попеля, 15

Телефон: 45-12-38

Інше: 47-34-13

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Національна академія наук України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270

Адреса: 01601, м.Київ-01, вул. Володимирська, 54

Підпорядкованість: Кабінет міністрів

Телефон: 221-15-56

E-mail: prez.@nas.gov.ua

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

КПКВК:

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Розробка багатофункціональних елементів і вузлів для систем керування та зв'язку на основі арсеніду галію

Назва роботи (англ)

Development of GaAs - based multifunctional control and communication elements and units

Реферат (укр)

Об єкт дослідження -активні елементи на основі GaAs. Метод дослідження - інформаційно-аналітичний та експериментальний. Розроблено проект технічного завдання на технологію виготовлення активних елементів на основі GaAs та технологічний процес обробки напівпровідникового матеріалу GaAs і формування омічних контактів до нього. Область застосування - виробництво напівпровідникових -пристроїв.

Реферат (англ)

The study is concerned with GaAs-based active elements.The investigation method is informational-analytical and experimental. A tentative requirements specification for GaAs-based active element technology has been drawn up, and a GaAs semiconductor material handling and ohmic contact formation process has been developed. The field of application is semiconductor device manufacturing

Індекс УДК: 621.37/.39.002.2; 621.37/.39.002.5, 621. 382

Коди тематичних рубрик НТІ: 47.13

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

54905490

8. Звітна документація

Робота виконується без звіту

9. Заключні відомості

Керівник організації:

Пилипенко Олег Вікторович (д. т. н., професор, член-кор.)

Керівники роботи:

Привалов Євген Миколайович

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.